

トランジスタ

2SC2076

2SC2076

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形/Si NPN Epitaxial Planar

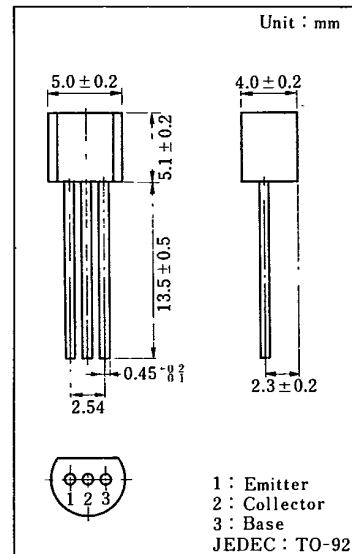
高周波増幅用/RF Amplifier

■ 特徴/Features

- AM/FM ラジオの RF 増幅, 発振, 混合, IF に最適です。
Suitable for RF amp., OSC, mix. and IF amp. in FM/AM radios.
- サージ破壊強度が大きい。/Large with standing capability against surge voltage.

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	35	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	30	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	4	V
コレクタ電流	I_C	20	mA
コレクタ損失	P_C	400*	mW
接合部温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	°C

*ポテンシャルタイプは $P_C = 250$ mW/Potting type : $P_C = 250$ mW.

■ 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 20$ V, $I_E = 0$			1	μ A
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C = 10$ μ A, $I_E = 0$	35			V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = 2$ mA, $I_B = 0$	30			V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = 10$ μ A, $I_C = 0$	4			V
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CE} = 10$ V, $I_C = 1$ mA	80		360	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 10$ mA, $I_B = 1$ mA			0.4	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB} = 10$ V, $-I_E = 1$ mA	80		200	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 10$ V, $I_E = 0$, $f = 1$ MHz			3.5	pF
雑音指数	NF	$V_{CB} = 10$ V, $-I_E = 1$ mA, $f = 100$ MHz			5	dB

* h_{FE} ランク分類/ h_{FE} Classifications

Class	B	C	D
h_{FE}	80 ~ 160	120 ~ 240	180 ~ 360

トランジスタ

T-31-15

2SC2076

